

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成24年12月20日(2012.12.20)

【公表番号】特表2012-507606(P2012-507606A)

【公表日】平成24年3月29日(2012.3.29)

【年通号数】公開・登録公報2012-013

【出願番号】特願2011-534764(P2011-534764)

【国際特許分類】

C 08 J	7/00	(2006.01)
C 08 J	3/24	(2006.01)
C 09 J	183/04	(2006.01)
C 09 J	11/04	(2006.01)
C 09 J	11/06	(2006.01)
C 09 J	7/02	(2006.01)
C 08 L	83/04	(2006.01)
B 32 B	27/00	(2006.01)
C 09 J	183/02	(2006.01)

【F I】

C 08 J	7/00	3 0 2
C 08 J	3/24	C F H
C 09 J	183/04	
C 09 J	11/04	
C 09 J	11/06	
C 09 J	7/02	Z
C 08 L	83/04	
B 32 B	27/00	1 0 1
C 09 J	183/02	

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月29日(2012.10.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

シリコーン材料を含む組成物をホットメルト処理する工程と、前記組成物を電子ビーム照射にさらして架橋シリコーン系材料を形成する工程とを含み、前記組成物には、実質的に触媒及び開始剤がない、架橋シリコーン系材料を作製する方法。

【請求項2】

請求項1に記載の方法によって作製された、架橋シリコーン系材料。

【請求項3】

第1の主面を有する基材と、前記基材の前記第1の主面の少なくとも一部分に接着されたシリコーン感圧性接着剤とを含む、接着性物品。